

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2025]7号

关于召开半导体材料标准项目论证会暨标准制修订 工作会议的通知

各位委员、各会员单位及相关单位：

为深入贯彻二十届三中全会精神，充分发挥标准化的基础性、引领性作用，落实《国家标准化发展纲要》及相关产业政策的要求，主动适应新形势，加速建设推动半导体材料行业高质量发展的新型标准体系，根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会的要求，兹定于2025年4月22日~4月25日在河南省洛阳市召开半导体材料标准项目论证会暨标准制修订工作会议。

会议将对各单位提出的国家标准、行业标准和协会标准计划项目进行论证，并对11项半导体材料标准进行审定、预审和讨论。请标委会委员务必出席会议，同时请各项目申报单位、起草单位及相关单位派代表参会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议内容

1、4月23日，领导讲话，终审待报批的标准项目，论证半导体材料国家标准、行业标准及协会标准计划申报项目。

请所有项目申报单位按照《关于征集2025年度半导体材料国家标准、行业标准、协会标准项目计划的通知》（半材标委[2025]1号）的要求，提前准备相关论证材料并派代表参会介绍，未派代表参会项目不予论证。

2、4月24日，对《硅外延用三氯氢硅中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》等11项半导体材料国家标准、行业标准和协会标准分组进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。

请各标准负责起草单位于4月11日前将相关标准稿件发送至秘书处邮箱(tc203sc2@cnsmq.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于4月15日之后在有色标准信息网(www.cnsmq.com)“标准制定工作站”栏目下载会议资料。

3、4月25日，早餐后返程。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2025年4月22日。

2、报到地点：洛阳欣源国际酒店（洛阳市老城区九都东路300号，电话：0379-63957888）。

3、乘车路线：①龙门高铁站：乘坐地铁2号线至牡丹桥下车C4出口，转乘7路公交车至定鼎立交桥西站下车，步行200米到达酒店；全程约12公里，乘出租车约20元。②洛阳火车站：乘坐81路公交车至应天门站下车，转乘106路公交车至定鼎立交桥东站下车，步行200米到达酒店；全程约5.4公里，乘出租车约15元。③洛阳北郊机场：乘坐1路公交车至王成广场站下车，转乘地铁1号线，从周王城广场地铁C口进站至丽景门站A出口，步行600米到达酒店；全程约15公里，乘出租车约20元。

三、会务及联系人

本次会议由麦斯克电子材料股份有限公司协办。

会议期间，食宿统一安排，宿费自理。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议会务组：13521167446（会议会务）、010-62257692（缴费、发票）。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于2024年4月15日前登录会议报名系统(<http://www.ysmeeting.net>)注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息。本次会议收取会议费850元/人。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，4月15日之后及现场缴费收取1200元/人。汇款请注明：半材洛阳会议（个人汇款请备注单位名称）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：审定、预审和讨论的标准项目

二〇二五年三月二十一日



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

审定、预审和讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	主编单位	备注
第一组				
1	国标委发（2024）16号 20240139-T-469	硅外延用三氯氢硅中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	洛阳中硅高科技有限公司	审定
2	国标委发（2024）16号 20240143-T-469	重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的测试 红外反射法	浙江金瑞泓科技股份有限公司	审定
3	国标委发（2024）16号 20240496-T-469	半导体晶片近边缘几何形态评价 第2部分：边缘卷曲法（ROA）	山东有研半导体材料有限公司	审定
4	国标委发（2024）44号 20243061-T-469	300 mm 硅外延片	浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司	预审
5	国标委发（2025）3号 20250087-T-469	集成电路用高纯硅靶材	宁波江丰电子材料股份有限公司	讨论
6	中色协科字（2024）80号 2024-063-T/CNIA	半导体外延用等静压石墨	四川福碳新材料科技有限公司	预审
第二组				
7	国标委发（2024）16号 20240137-T-469	蓝宝石图形化衬底表面图形几何参数的测定方法	广东中图半导体科技股份有限公司	预审
8	国标委发（2025）3号 20250093-T-469	氮化铝单晶复合衬底	松山湖材料实验室	讨论
9	国标委发（2024）28号 20241934-T-469	太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片	南京集溢半导体科技有限公司	预审
10	国标委发（2024）44号 20243065-T-469	激光器外延芯片用砷化镓衬底	广东先导微电子科技有限公司	预审
11	工信厅科（2024）18号 2024-0218T-YS	高纯砷	峨眉山嘉美高纯材料有限公司	审定